PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-232257

(43) Date of publication of application: 19.08.1994

(51)Int.Cl.

H01L 21/78

(21)Application number: 05-014383

(71) Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

01.02.1993

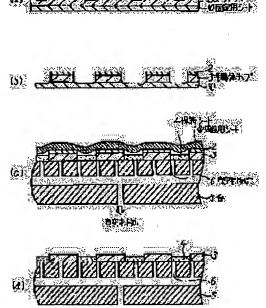
(72)Inventor: AMASHIRO RIYUUICHI

(54) METHOD OF DICING WAFER INTO SEMICONDUCTOR CHIPS

(57) Abstract:

PURPOSE: To stick a contamination-preventing protective sheet to a wafer so that dust particles do not adhere to an element formation face, to enhance the efficiency of separating the protective sheets from ships after the wafer have been diced into chips and to increase the efficiency of dicing a wafer into semiconductor chips.

CONSTITUTION: A wafer to which a protective sheet 3 is stuck is diced into semiconductor chips 3 in a dicing process and the semiconductor chips 3 are placed on a stage 5 which is provided with vacuum evacuation holes 6 at a distance from the stage by a holding sheet 4. They are covered with a sheet 1, for separation, whose adhesive force is stronger than the adhesive force of the protective sheet 2. They are bonded. An evacuation operation is performed from the vacuum evacuation holes 6. The semiconductor chips 3 are attracted and fixed more strongly. The sheet 1 for separation is separated along with the protective sheet 2. Thereby,



1-055-

the protective sheet 2 is separated from the semiconductor chips 3.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.02.1993

[Date of sending the examiner's decision of

26.03.1996

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-232257

(43)公開日 平成6年(1994)8月19日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/78

P 8617-4M

L 8617-4M

審査請求 有 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平5-14383

44844-0 - 14000

(22)出願日

平成5年(1993)2月1日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号 .

(72)発明者 天白 竜一

東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式

会社内

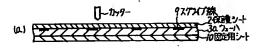
(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

(54) 【発明の名称】 半導体チップの分割分離方法

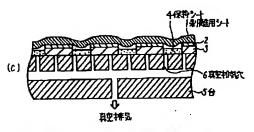
(57) 【要約】

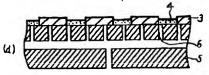
[目的] 素子形成面にごみが付着しないために汚染防止の保護シート2をウェーハ3 a に貼り、半導体チップ3 に分割分離後に保護シートを剥す剥離効率を向上させ、同時に半導体チップの分割分離の作業効率を高める。

【構成】ダイシング工程で分割分離され保護シート2が 貼付けられた半導体チップ3を保持シート4で間隔をも たせて真空排気穴6をもつ台5に並べ載置し、保護シート2の接着力の強い接着力をもつ剥離用シート1を被せ 接着し、真空排気穴6から排気して半導体チップ3をよ り強力に吸着固定し、保護シート2を伴なわせて剥離用 シート1を剥すことで、保護シート2を半導体チップ3 より剥している。









【特許請求の範囲】

【請求項1】 区画された複数の素子形成領域が縦横に 並べ形成されたウェーハの該素子形成面に保護シートを 該ウェーハの裏面に固定用シートをそれぞれ貼付けるる 工程と、これらシートで挟み保持される前記ウェーハの 前記区画線に沿って前記保護シートの上からカッターで 切込み複数の半導体チップに分割する工程と、前記固定 用シートを拡張して前配半導体チップの間隔を拡げ前配 固定用シートから前記半導体チップを取外す工程と、複 つ保持シートの該穴に前記半導体チップを入れ該第1の 台に載置する工程と、前記保護シートの上に剥離用シー トを被せ接着する工程と、前記真空排気穴より排気し前 記半導体チップを前配第1の台に吸着固定して前記剥離 用シートの剥しに伴ない前記保護シートを剥す工程とを 含むことを特徴とする半導体チップの分割分離方法。

【請求項2】 前記ウェーハの該素子形成面に前記保護 シートを貼付ける工程と、複数の前記カッターの逃げ滯 と前記真空排気穴をもつ第2の台に前記保護シートを上 にして前記ウェーハを載置し前記区画線に沿って前記保 20 護シートの上から前記カッターで切込み複数の前記半導 体チップに分割する工程と、前記真空排気穴より排気し 前記半導体チップを前記第2の台に吸着固定して前記剥 離用シートの剥しに伴ない前記保護シートを剥す工程と を含むことを特徴とする請求項1記載の半導体チップの 分割分離方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ウェーハより半導体チ ップに分割分離する半導体チップの分割分離方法に関 30 し、特に素子形成面にごみ付着防止のために保護シート を貼付ける必要がある半導体チップの分割分離方法に関 する。

[0002]

【従来の技術】一般にホトトランジスタ、発光ダイオー ド及び提像素子等の半導体チップは、ウェーハをダイシ ングし分離分割する際に素子形成面が汚れないように保 護シートを貼付け、そしてマウント工程の前でこの保護 シートを剥して組立を行なっていた。

【0003】図3は従来の半導体チップの分割分離方法 40 の一例を説明するためのラミネートされた半導体チップ を示す断面図である。この半導体チップの分割分離方法 は、まず、区画された複数の素子形成領域が縦横に並べ 形成されたウェーハの素子形成面に保護シートを貼付 け、裏面には粘着シートを貼付ける。次に、両面をシー トで挟みラミネートされたウェーハをダイシング装置で 区画線に沿ってカッターを切込み半導体チップに分割す る。次に、粘着シートを外側に引張ることにより拡張 し、半導体チップを粘着シートから剥し易いように各半 導体チップの間隔を拡げる。そして、粘着シートに残っ 50

た半導体チップ3の良品を固定用シート上に移し配列し 直す。

【0004】次に、図3に示すように、保護シート2が 貼付いた半導体チップ3の上に剥離用シート1を乗せ、 ローラなどで軽く押さえて剥離用シート1と保護シート と接着する。ここで、各シートの接着力は、固定用シー ト10が最も強く、剥離用シート1、保護シートの順に 弱くしてある。次に、この状態で下方から紫外線(U V)を照射し、接着剤を硬化させ接着力を弱くさせる。 数の真空排気穴をもつ第1の台に載置され複数の穴をも 10 そして固定用シート10を保持して剥離用シート1を剥 すことによって剥離用シート1に伴なわれて保護シート 2は半導体チップ3から剥れる。そして次工程のマウン ト工程へ進めるため、固定シート10上の半導体チップ 3 を層度一枚ずつ剥しマウント装置の剛性のあるピック アップ用ステージに移載する。

> 【0005】このようにダイシングによるウェーハから の半導体チップへの分割分離する際に、素子形成面に保 護シートを貼付け行なうことにより素子形成面が汚染さ れることなく性能を維持し分割分離を行っていた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来の半 導体チップの分割分離方法では、固定シートは柔軟な板 材であり、安定して保持固定が難しい上に紫外線照射に よる接着材の劣化が一葉に施されることなく、しばしば 保護シートが剥れず固定用シートから外れ、保護シート の剥離率を低下させるという問題がある。また、ダイシ ング後良品を選別して配列し直したり、次工程に進める ために固定シートから半導体チップを剥したり無駄な作 業が多く、いたずらに工数を浪費する欠点があった。

【0007】本発明の目的は、作業効率が良く保護シー トを確実に剥離出来、かつ作業効率が良い半導体チップ の分割分離方法を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の特徴は、区画さ れた複数の素子形成領域が縦横に並べ形成されたウェー ハの該索子形成面に保護シートを該ウェーハの裏面に固 定用シートをそれぞれ貼付けるる工程と、これらシート で挟み保持される前配ウェーハの前配区画線に沿って前 記保護シートの上からカッターで切込み複数の半導体チ ップに分割する工程と、前配固定用シートを拡張して前 記半導体チップの間隔を拡げ前記固定用シートから前記 半導体チップを取外す工程と、複数の真空排気穴をもつ 第1の台に載置され複数の穴をもつ保持シートの骸穴に 前記半導体チップを入れ該第1の台に載置する工程と、 前記保護シートの上に剥離用シートを被せ接着する工程 と、前記真空排気穴より排気し前配半導体チップを前記 第1の台に吸着固定して前記剥離用シートの剥しに伴な い前記保護シートを剥す工程とを含む半導体チップの分 割分離方法である。

【0009】また、他の特徴は、前記ウェーハの該素子

形成面に前記保護シートを貼付ける工程と、複数の前記 カッターの逃げ溝と前記真空排気穴をもつ第2の台に前 記保護シートを上にして前記ウェーハを載置し前記区画 線に沿って前記保護シートの上から前記カッターで切込 み複数の前記半導体チップに分割する工程と、前記真空 排気穴より排気し前記半導体チップを前記第2の台に吸 着固定して前記剥離用シートの剥しに伴ない前記保護シ ートを剥す工程とを含む半導体チップの分割分離方法で ある。

[0010]

【実施例】次に、本発明について図面を参照して説明す

【0011】図1 (a)~(d)は本発明の半導体チッ プの分割分離方法の一実施例を説明するための工程順に 示すラミネート構造の断面図である。この半導体チップ の分割分離方法は、まず、図1 (a) に示すように、従 来例と同じように、ウェーハ3aの素子形成面に保護シ ート2を裏面に固定用シート10をそれぞれ貼付け、ダ イシング装置でカッターを区画線であるスクライブ線9 に沿って走行させ固定用シート10まで切込みウェーハ 20 3 a を切断する。次に、図1 (b) に示すように、弾性 のある固定用シート10を外側に引張り拡張させて分割 された半導体チップ3の間隔を拡げる。

【0012】次に、図1 (c) に示すように、真空排気 穴6が多数開けられた剛性ある台5と半導体チップ3が 容易に挿入される穴が等間隔で縦横に並べ複数個開けら れた保持シート4を予じめ準備し、台5の上に保持シー ト4を敷く。そして、固定用シート10に披着する半導 体チップ3から良品を選び、選ばれた半導体チップ3を 固定用シート10より剥し保持シート4の穴に入れ台5 に移載する。次に、半導体チップ3の保護シート2の上 に剥離用シート1を貼付ける。

【0013】次に、真空排気穴6を通し真空排気して半 導体チップ3を台5に1平方メートル当り約10Kgの 吸引力で吸着固定させる。そして半導体チップ3を確実 に固定されていることを確認してから剥離用シート1を 剥す。このことにより、図1 (d) に示すように保護シ ート2は剥離用シート1に伴なわれて半導体チップ3よ り剥される。そして次工程であるマウント工程に半導体 のピックアップステージに台を設置する。

【0014】ここで、保持シート4の厚さは半導体チッ プ3より薄くしてあり、後工程であるマウント工程でピ ックアップし易いようにすることが望ましい。また、半 導体チップ3の挿入する穴は大きいチップでも挿入出来 るように少し大きめでも良い。さらに、真空排気穴6は 半導体チップ3が載置される場所だけでも良い。

【0015】この半導体チップの分割分離方法では、従 来、行なっていたUV線照射による接着剤脆弱させる工 程と固定シートに再配列する作業の必要が無くなり、作 50 外線照射による接着力の脆化処理作業が不要になり、**剛**

業時間がウェーハー枚当り20分短縮出来た。また、半 導体チップを剛性ある台に真空吸着で固定するので、従 来の柔軟なシートで接着して固定に比べ安定して固定で きるので、保護シートの剥離率より5パーセント向上す ることご出来た。

【0016】図2(a)~(c)は本発明の半導体チッ プの分割分離方法の他の実施例を説明するための工程順 に示すラミネート構造の断面図である。この半導体チッ プの分割分離方法は、まず、図2(a)に示すように、 10 真空排気穴6及びカッター逃げ8をもつ台5aを予じめ 準備し、この台5aに素子形成面に保護シート2が貼付 けられたウェーハ3aを乗せる。次に、保護シート2が 貼付けられたウェーハ3aとウェーハ3aを載置する台 5 a をダイシング装置のステージに乗せ、スクライブ線 9に沿って保護シート2の上からカッターを切込みウェ ーハ3aを複数の半導体チップ3に分割する。

【0017】次に、図2(b)に示すように、保護シー ト2に剥離用シート1を被せ、ローラ等で剥離用シート 1の上を押し保護シート2に剥離用シート1を貼付け る。次に、真空排気穴6から排気し、凡そ1平方メート ル当り約10Kgの吸引力で台5aに半導体チップ3を 吸着固定させる。そして、固定されていることを確認し 剥離用シート1を剥すことにより、接着力の弱い保護シ ート2と半導体チップ3とは剥れ、保護シート2を半導 体チップ3より取去ることが出来る。次に、真空排気を 停止し、半導体チップ3の保持を開放し、不良の半導体 チップ3は台5aより取除き、良品のみ台5aに残した ままにする。次に、図2 (c) に示すように、半導体チ ップ3を乗せた台5aをマウント装置のピックアップス テージに乗せる。

【0018】この実施例における半導体チップの分割分 離方法は、前述の実施例に比べ固定シートに再配列する 作業が無くなり、その分さらに一ウェーハ当り10分程 度短縮することが出来た。ただ、半導体チップの間隔が 狭く、マウント装置で半導体チップを掴み難いが、森子 形成面を汚染しない吸着パッドを使用するば、実用上問 題を起きない。

[0019]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、真空吸着 チップ3を搭載した台5ごと持っていき、マウント装置 40 する半導体チップの剛性ある載置台を準備し、汚染防止 のために保護シートが貼付けられたウェーハから複数の 保護シート付き半導体チップに分割分離し、分割された 半導体チップを前記台に乗せ吸着保持し確実に固定して から、前記保護シートの接着力のより強い剥離用シート を貼付け、接着力の弱い保護シートを伴なって剥離用シ ートを剝すことが出来るので、保護シートからの半導体 チップの剥離率が向上するという効果がある。

> 【0020】また、剥離用シートの接着力より強い真空 吸着力で固定することにより、従来、行なわれていた紫

5

性ある台上で半導体チップが分離され載置されるので、 直接台を移行するだけでマウント工程への移行が済み、 従来、移行のために行なわれていた半導体チップの移し 変えて再配列する作業も無くなり、作業効率がいちじる しく向上した。

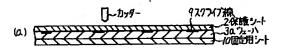
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体チップの分割分離方法の一実施例を説明するための工程順に示すラミネート構造の断面図である。

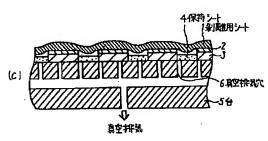
【図2】本発明の半導体チップの分割分離方法の他の実施例を説明するための工程順に示すラミネート構造の断面図である。

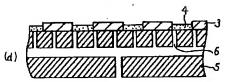
【図3】従来の半導体チップの分割分離方法の一例を説

[図1]

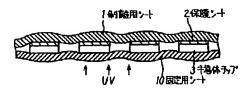








[図3]



明するためのラミネートされた半導体チップを示す断面 図である。

【符号の説明】

1 剥離用シート

2 保護シート

3 半導体チップ

3a ウェーハ

4 保持シート

5,5a 台

6 真空排気穴

8 カッター逃げ

9 スクライブ線

10 固定用シート

[図2]

